

Содержание

● Атомная структура и неэлектронные свойства полупроводников

Музафарова С.А., Айтбаев Б.У., Мирсагатов Ш.А., Дуршимбетов К., Жанабергенов Ж.

Исследование промежуточного слоя на гетерогранице n^+ -CdS/ p -CdTe 1409

● Электронные и оптические свойства полупроводников

Алиев С.А., Агаев З.Ф., Селим-заде Р.И.

Энергетический спектр носителей заряда в Ag_2Te 1415

Поклонский Н.А., Вырко С.А., Забродский А.Г.

Расчет электрической емкости самокомпенсированных полупроводников с межцентровыми прыжками одного и двух электронов (на примере кремния с радиационными дефектами) 1420

Агеева Н.Н., Бронева И.Л., Кривоносов А.Н.

Субтерагерцовые автоколебания в сверхбыстрой автоматодуляции поглощения света в GaAs 1426

● Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность

Романов В.В., Моисеев К.Д., Воронина Т.И., Лагунова Т.С., Яковлев Ю.П.

Разъединенный гетеропереход II-типа $GaSb_{1-x}As_x/InAs$ ($x < 0.15$): эволюция зонной энергетической диаграммы тройного твердого раствора 1434

Санкин В.И., Шкробий П.П.

Гигантский всплеск ударной ионизации в $p-n$ -переходе политипа $6H-SiC$ 1439

Поцяск М., Ижнин И.И., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н., Сидоров Ю.Г., Варавин В.С., Мынбаев К.Д., Иванов-Омский В.И.

Электрические свойства гетероэпитаксиальных слоев $HgCdTe$ n -типа проводимости, модифицированных ионным травлением 1444

Гуткин А.А., Рудинский М.Э., Брунков П.Н., Клочихин А.А., Давыдов В.Ю., Шеп Н.-У., Gwo S.

Поверхностные состояния на границе раздела $n-InN$ -электролит 1448

● Низкоразмерные системы

Жмерик В.Н., Мизеров А.М., Шубина Т.В., Сахаров А.В., Ситникова А.А., Копьев П.С., Иванов С.В., Луценко Е.В., Данильчик А.В., Ржеуцкий Н.В., Яблонский Г.П.

Квантово-размерные гетероструктуры на основе AlGaIn для светодиодов глубокого ультрафиолетового диапазона, полученные методом субмонослойной дискретной молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота 1452

Семина М.А., Сергеев Р.А., Сурис Р.А.

Энергия связи экситона и X^+ , X^- -трионов в одномерных системах 1459

● Физика полупроводниковых приборов

Иванов А.М., Строкан Н.Б., Лебедев А.А.

К вопросу радиационной стойкости SiC при чередовании стадий облучения и отжига 1466

Зверев М.М., Гамов Н.А., Жданова Е.В., Перегудов Д.В., Студенов В.Б., Седова И.В., Гронин С.В., Сорокин С.В., Иванов С.В., Копьев П.С.

Эффективный полупроводниковый лазер зеленого диапазона с электронно-лучевой накачкой на основе многослойных наноструктур $A^{II}B^{VI}$ 1472

● Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Самсоненко Ю.Б., Цырлин Г.Э., Егоров В.А., Поляков Н.К., Улин В.П., Дубровский В.Г.

Особенности формирования нитевидных нанокристаллов GaAs на различных поверхностях кремния при молекулярно-пучковой эпитаксии 1478

Авров Д.Д., Булатов А.В., Дорожкин С.И., Лебедев А.О., Таиров Ю.М.

Рост слитков карбида кремния политипа $4H$ на затравках с плоскостью $(10\bar{1}0)$ 1483

Именной указатель 1488

Предметный указатель 1513